

	<h2>SI7913DN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7913DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 5A PPAK 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7913DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1180 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7913DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 5A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1180 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 5A 1.3W Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.3W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37 mOhm @ 7.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	SI7913
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7913DN-T1-GE3CT

SI7913DN-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7913DN-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7913DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7913DN-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7913DN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 5A 1212-8</p>	 <p>SI7913DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 5A 1212-8</p>	 <p>SI7922DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8</p>	 <p>SI7922DN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8</p>
 <p>SI7913DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 5A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7913DN-T1-G3E VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SI7922DN VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SI7922DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI7901EDN-T1-E3 ⊖ SI7904BDN-T1-GE3 ⊕ SI7904DN-T1-GE3 D SI7909DN-T1-E3 ⇒ SI7911DN-T1-E3 ↔ SI7913DN-T1-GE3 ⊕ SI7923DN-T1-E3 ⊖ SI7938DP-T1-GE3 ⊕ SI7941DP-T1-GE3 ↔ SI7942DP-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ SI7901EDN-T1-E3 ⊕ SI7904DN ⊖ SI7904DN-T1-GE3 ⊕ SI7909DN-T1-GE3 ↔ SI7911DN-T1-GE3 ⇒ SI7922DN-T1-E3 D SI7923DN-T1-E3 ⊕ SI7940DP ⊖ SI7942DP ⊕ SI7945DP-T1-E3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7904BDN-T1-E3 D SI7904DN-T1 ⊕ SI7905DN-T1-GE3 ⊖ SI7909DN-T1-GE3 ⊕ SI7911DN-T1-GE3 D SI7922DN-T1-E3 ⇒ SI7923DN-T1-GE3 ↔ SI7940DP-T1-E3 ⊕ SI7942DP-T1-E3 ⊖ SI7945DP-T1-E3 	<ul style="list-style-type: none"> D SI7904BDN-T1-E3 ⇒ SI7904DN-T1-E3 ↔ SI7905DN-T1-GE3 ⊕ SI7911DN ⊖ SI7913DN-T1-E3 ⊕ SI7922DN-T1-GE3 ↔ SI7923DN-T1-GE3 ⇒ SI7940DP-T1-E3 D SI7942DP-T1-E3 ⊕ SI7946DP 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7904BDN-T1-GE3 ⇒ SI7904DN-T1-E3 ⇒ SI7909DN-T1-E3 ⇒ SI7911DN-T1-E3 ⇒ SI7913DN-T1-E3 ⊖ SI7922DN-T1-GE3 ⇒ SI7938DP-T1-GE3 ⇒ SI7941DP-T1-E3 ⇒ SI7942DP-T1-GE3 ⇒ SI7946DP-T1-E3
--	--	--	--	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited